

# Central<sup>TM</sup> Semiconductor Corp.

145 Adams Avenue, Hauppauge, NY 11788 USA  
Tel: (631) 435-1110 • Fax: (631) 435-1824

Manufacturers of World Class Discrete Semiconductors

1N3600  
1N4150

SILICON SWITCHING DIODE

JEDEC D0-35 CASE

## DESCRIPTION

The CENTRAL SEMICONDUCTOR 1N3600, 1N4150, silicon planar epitaxial diode is characterized by its miniature size, ultra fast switching speed, low capacitance, low leakage, and high conductance. Accordingly, it is ideally suited for applications such as pulse applications, avalanche circuits, core drivers, and for any critical circuit requiring high conductance at power dissipation without sacrificing fast recovery capability. (Both devices have identical electrical and mechanical specifications).

## MAXIMUM RATINGS (T<sub>A</sub>=25°C)

	SYMBOL		UNIT
Peak Working Inverse Voltage	V <sub>RWM</sub>	50	V
Average Forward Current	I <sub>O</sub>	200	mA
Forward Steady State Current	I <sub>F</sub>	400	mA
Recurrent Peak Forward Current	i <sub>f</sub>	600	mA
Peak Forward Surge Current (1.0s Pulse)	I <sub>FSM</sub>	1.0	A
Peak Forward Surge Current (1.0us Pulse)	I <sub>FSM</sub>	4.0	A
Power Dissipation	P <sub>D</sub>	500	mW
Operating and Storage Junction Temperature	T <sub>J</sub> , T <sub>STG</sub>	-65 to +200	°C

## ELECTRICAL CHARACTERISTICS (T<sub>A</sub>=25°C unless otherwise noted)

SYMBOL	TEST CONDITIONS	MIN	MAX	UNIT
I <sub>R</sub>	V <sub>R</sub> =Rated V <sub>RWM</sub>		100	nA
I <sub>R</sub>	V <sub>R</sub> =Rated V <sub>RWM</sub> , T <sub>A</sub> =150°C		100	μA
BV <sub>R</sub>	I <sub>R</sub> =5.0μA	75		V
V <sub>F</sub>	I <sub>F</sub> =1.0mA	0.54	0.62	V
V <sub>F</sub>	I <sub>F</sub> =10mA	0.66	0.74	V
V <sub>F</sub>	I <sub>F</sub> =50mA	0.76	0.86	V
V <sub>F</sub>	I <sub>F</sub> =100mA	0.82	0.92	V
V <sub>F</sub>	I <sub>F</sub> =200mA	0.87	1.0	V
C	V <sub>R</sub> =0V, f=1.0MHz		2.5	pF
t <sub>fr</sub>	V <sub>f</sub> =1.0V, I <sub>f</sub> =200mA, t <sub>r</sub> =0.4ns		10	ns
t <sub>rr</sub>	I <sub>f</sub> =I <sub>r</sub> =10mA to 200mA, R <sub>L</sub> =100Ω		4.0	ns
t <sub>rr</sub>	I <sub>f</sub> =I <sub>r</sub> =200mA to 400mA, R <sub>L</sub> =100Ω		6.0	ns

# Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Central Semiconductor:](#)

[1N4150](#) [1N3600](#) [1N3600 TR](#)

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)